Université du Québec en Outaouais

Sigle: GEN1103 Gr. 01 Titre: Électronique

Session: Automne 2021 Horaire et local

Professeur: Eftimov, Tinko

1. Description du cours paraissant à l'annuaire :

Objectifs

Au terme de cette activité, l'étudiant(e) sera en mesure : d'appliquer les principes d'opération des diodes, transistors à jonction bipolaire et transistors à effet de champs dans le domaine d'électronique.

Contenu

Structure et propriétés de base des semi-conducteurs. Densité et déplacement des porteurs de charge dans les semi-conducteurs. Jonction PN: polarisation directe et inverse, capacité, régime transitoire, claquage. Jonction métal semi-conducteur. Diodes à jonction : diode Zener. Composants optoélectroniques: photodiode, cellule photovoltaïque, diode électroluminescente (DEL), diode laser. Transistors bipolaires : effet transistor, fabrication, caractéristiques, polarisation, amplification, commutation, effets thermiques. Transistors à effet de champ : à jonction (JFET) et à grille isolée (MOSFET).

Descriptif - Annuaire

2. Objectifs spécifiques du cours :

Le cours couvre 2 des 12 qualités requises des diplômé(e)s telles que définies dans les normes d'agrément des programmes de génie au Canada (http://www.engineerscanada.ca/fr/ressources-en-matiere-dagrement) :

- 1. Qualité 1 : Connaissances en génie
- 2. Qualité 4 : Conception

Les qualités 1 et 4 sont mesurées dans ce cours pour fins de rétroaction.

Objectifs spécifiques	Qualité	Indicateurs	Introduit	Développé	Appliqué
Connaître les principes d'opération des diodes, transistors à jonction bipolaire et transistors à effet de champs dans le domaine d'électronique	1	3. Comprendre et appliquer les notions fondamentales de l'ingénierie.	x		
Concevoir un système électronique en utilisant des diodes, transistors	4	3. Créer des modèles, simulations, prototypes et faire des tests.	x		

3. Stratégies pédagogiques :

Les formules pédagogiques suivantes seront utilisées :

- Cours magistral (une période par semaine) : Présentiel, 3x1 avec pauses
- **Proiet**: 1 proiet
- Séances de travaux pratiques, 5 présentiel au laboratoire
- Lecture personnelle

Lien utile : <u>COVID-19</u>: <u>Modalités de tenue des séances de travaux pratiques (TP) et de projets dans les laboratoires de génie A2021</u>

4. Heures de disponibilité ou modalités pour rendez-vous :

Le mercredi entre 11 h 30 et 12 h 30 en au bureau B 2018.

5. Plan détaillé du cours sur 15 semaines :

Semaine	Thèmes	Dates
1	 Équilibre thermique Distribution d'énergie : fonction de Fermi-Dirac Énergie Fermi Les bandes d'énergie des semiconducteurs Types de semiconduction : intrinsèque et extrinsèque Concentrations des porteurs d'équilibre et de déséquilibre 	mercredi 08 sept. 2021
2	La jonction p-n.La diode semiconducteur. Diodes à usage particulier. La jonction p-n: structure et principe d'opération Équilibre thermique Biais direct et inverse Caractéristiques électrostatiques de la jonction La diode semiconducteur. Caractéristique I-V de la jonction. Diode Zener, TVS, Capacitance variable Séance obligatoire de familiarisation au laboratoire (jeudi 16 sept. 2021) en présentiel	mercredi 15 sept. 2021
3	 Applications des diodes Modèles et paramètres de la diode Redressement simple et double alternance Stabilisation de la tension 	jeudi 23 sept.2021
4	Composants optoélectroniques: diode électroluminescente (DEL), diode laser • Types de bandes interdites : directe et indirecte • La diode électroluminescente (DEL). Caractéristiques et paramètres. • La diode laser (DL). Caractéristiques et paramètres. Travail pratique 1- Diodes à jonction p-n (mercredi 29 sept. 2021) en présentiel	jeudi 30 sept.2021
5	 Composants optoélectroniques: photodiode, cellule photovoltaïque La photodiode p-n, p-i-n et à avalanche Régimes d'opération: mode photoconductive et mode photovoltaïque La cellule photovoltaïque Applications des photodiodes Travail pratique 2 – Caractéristique de diodes Zener (mercredi 06 oct. 2021) en présentiel 	jeudi 07 oct.2021
6	Semaine d'études	13 oct. 2021
7	Examen de mi-session Via Moodle, à livre ouvert	jeudi 21 oct. 2021
8	Transistors bipolaires à jonction Transistors bipolaires à jonction : structure et principe d'opération Modèles d'un transistor Réseau de caractéristiques d'un transistor bipolaire Caractéristiques d'entrée, de transfert et de sortie	jeudi 28 oct. 2021

	Mesure de paramètres d'un transistor bipolaire à jonction	
	Lancement du projet	
	Travail pratique 3 - Point d'opération d'un transistor bipolaire et stabilité thermique (mercredi 27 oct. 2021) en présentiel	
	Circuits de polarisation du transistor. Phototransistors.	
9	 Montages émetteur commun, collecteur commun, base commune Circuits de polarisation du transistor pour chaque montage Phototransistors 	mercredi 03 nov. 2021
	Jonction métal-semiconducteur. Diodes Schottky.	
10	 Jonction métal-semiconducteur Diodes Schottky 	mercredi 10 nov. 2021
	Travail pratique 4 – Dispositifs photoniques –DEL, photodiodes et phototransistors (jeudi 11 nov. 2021) en présentiel	
	Structures MOS	mercredi 17
11	Structure MOS. Principe d'opération.Condensateur MOS	nov. 2021
	Transistors à effet de champ MOSFET et JFET	
12	 Structure d'un transistor à effet de champ Transistors à effet de champ JFET Transistors à effet de champ MOSFET Travail pratique 5 -Transistor à effet de champ à jonction (JFET) (jeudi 25 nov. 2021) en présentiel 	mercredi 24 nov. 2021
	Circuit de polarisation MOSFET et JFET et applications	
13	 Circuits de polarisation Calculs Révision 	mercredi 01 déc. 2021
14	Examen final en présentiel	mercredi 08 déc. 2021
15	Semaine de présentation des projets (présentations en ligne) Non-présentiel	mercredi 15 déc. 2021

Outil d'évaluation	Pondération	Indicateurs évalués
Travaux pratiques (5 sessions)	20%	
Devoirs	10%	
Projet	15%	4.3
Examen de mi-session	20%	1.3
Examen final	35%	1.3

Il faut obtenir une moyenne minimale de 50 % aux travaux pratiques pour que les notes des travaux comptent.

Par **indicateur mesuré**, on entend qu'à la fin du cours, un niveau de performance (0, 1, 2, 3) est donné pour chaque indicateur et pour chaque étudiant(e) selon la grille ci-dessous :

Indicateurs	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
1.3- Comprendre et appliquer les notions fondamentales de l'ingénierie.	Moins de 52 %	Entre 52 et 63 %	Entre 64 et 83 %	Plus de 84 %
4.3- Créer des modèles, simulations, prototypes, et faire des tests.	Création de modèles, simulations, prototypes et/ou exécution des tests inadéquate ou inexistante.	Création acceptable de modèles, simulations, prototypes, mais exécution de tests insuffisante.	Création de modèles, simulations, prototypes et exécution de tests adéquate.	Création de modèles, simulations, prototypes et exécution de tests remarquable.

7. Politiques départementales et institutionnelles :

- Politique du département d'informatique et d'ingénierie relative à la tenue des examens
- Note sur le plagiat et sur la fraude
- Politique relative à la qualité de l'expression française écrite chez les étudiants et les étudiantes de premier cycle à l'UQO
- Absence aux examens : <u>cadre de gestion</u>, <u>demande de reprise d'examen (formulaire)</u>

À l'UQO, les violences à caractère sexuel, c'est tolérance zéro!

La communauté universitaire s'engage à lutter contre les inconduites, le harcèlement et les violences à caractère sexuel : parce que **le respect, c'est l'affaire de tout le monde!**

N'oubliez pas de faire la formation obligatoire :

uqo.ca/bimi/formation-obligatoire

Pour de plus amples renseignements :

bimi@uqo.ca



8. Principales références :

- 1. Van Zoeghbroeck « Principles of semiconductordevices » Publication sur Internet <u>www.semi1source.com</u>
 - a. Semiconductor Linkshttp://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/contents.htm
 - b. Miscellaneous
 - c. « Principles of semiconductordevices »
- 2. Électronique : Composants et systèmes d'application, 5^e édition. Thomas L. Floyd. Les éditions Reynald Goulet. Inc, 2000.
- 3. Semiconductor Devices Physics and Technology, 2nd Edition, S. M. Sze, John Wiley & Sons Inc., 2002.
- 4. Physique des semiconducteurs et des composants électroniques, 5e édition, Henry Mathieu, Dunod, 2004.
- 5. Micro et nano-électronique, Hervé Fanet, Dunod, 2005.
- 6. Notes du cours du professeur.

9. Page Web du cours:

https://moodle.ugo.ca